

【公報種別】特許法（平成6年法律第116号による改正前。）第64条の規定による補正

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成9年（1997）9月3日

【公告番号】特公平5-49696

【公告日】平成5年（1993）7月27日

【年通号数】特許公報5-1243

【出願番号】特願昭58-176995

【特許番号】1997572

【国際特許分類第6版】

C08G 59/62 NJF 8416-4J

59/40 NJL 8416-4J

C08K 5/54 NLC 9167-4J

C08L 63/00 NJS 8416-4J

H01L 23/29

23/31

【F I】

H01L 23/30 R 6921-4E

【手続補正書】

1 「特許請求の範囲」の項を「1 半導体装置をエポキシ樹脂組成物で封止して成る樹脂封止型半導体装置において、エポキシ樹脂組成物が、

（a） エポキシ樹脂；

（b） 硬化剤として1分子中に少なくとも2個のフェノール性水酸基を有するエポキシ樹脂硬化剤及び酸無水物からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物；

（c） 硬化促進剤として有機ホスフィン化合物；及び

（d） カルボキシ基を有する有機ケイ素化合物を含むことを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

2 エポキシ樹脂が、エポキシ当量170～300のノボラック型エポキシ樹脂である特許請求の範囲第1項記載の樹脂封止型半導体装置。

3 エポキシ樹脂硬化剤が、ノボラック型フェノール樹脂である特許請求の範囲第1項記載の樹脂封止型半導体装置。

4 有機ケイ素化合物が、カルボキシ基を有するポリシロキサン化合物及び／又はカルボキシ基を有するシラン化合物である特許請求の範囲第1項記載の樹脂封止型半導体装置。」と補正する。

2 第8欄12～17行「本発明のエポキシ……配合してもよい。」を削除する。

3 第9欄29～35行「製造例……反応混合物を得た。」を削除する。

4 第9欄36行，第10欄8行，23行および28行「実施例1～3」を「実施例1，2」と補正する。

5 第9欄44行「及び」を「又は」と補正する。

6 第10欄1～2行「並びに製造例で得た反応混合物を用い」を削除する。

7 第5頁～第6頁「表-1」を「

表-1

	実施例		比較例		
	1	2	1	2	3
エポキシ樹脂A	180	180	180	180	180
〃 B	20	20	20	20	20
フェノール樹脂	100	90	100	90	80
2-トリフェニルシリル 酢酸	5	—	—	—	—
カルボキシル当量3500 のメチルポリシロキサン	—	8	—	8	—
トリフェニルホスフィン	5	5	5	—	—
2-ヘプタデシル イミダゾール	—	—	—	5	5
石英ガラス粉末	700	700	700	700	700
三酸化アンチモン	20	20	20	20	20
カルナバワックス	4	4	4	4	4
カーボンブラック	4	4	4	4	4
シランカップリング剤	4	4	4	4	4

」と補正する。

8 第6頁「表-2」を「

表-2

試料 (N)	バイアスPCT累積不良率 (%)				
	100	150	200	250	300
実施例1	0	0	0	0	2
〃 2	0	0	0	0	5
比較例1	0	0	0	24	65
〃 2	72	100	—	—	—
〃 3	100	—	—	—	—

」と補正する。

9 第6頁「表-3」を「

表-3

試料 時間 (min)	MOS-BT試験 累積不良率 (%)				
	50	100	500	1000	1500
実施例1	0	0	0	0	3
〃 2	0	0	0	0	4
比較例1	0	0	0	46	100
〃 2	85	100	—	—	—
〃 3	100	—	—	—	—

」と補正する。

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**